

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
PUBLIC RELATIONS DIVISION
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokio 100-8310 (Japón)

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA

N.º 3132

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Consultas de los clientes

Semiconductor & Device Marketing Div. B
Mitsubishi Electric Corporation

www.MitsubishiElectric.com/semiconductors

Consultas de los medios

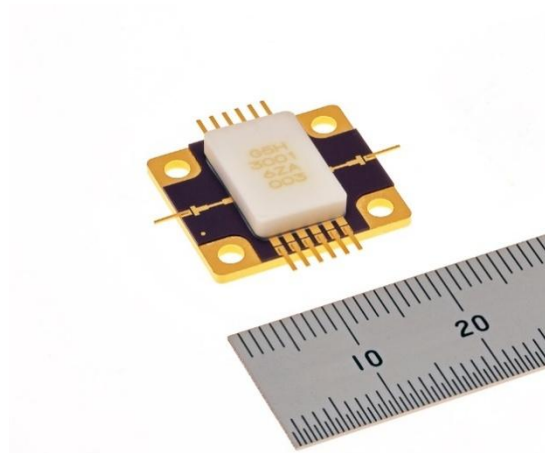
Public Relations Division
Mitsubishi Electric Corporation
prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp

www.MitsubishiElectric.com/news

Mitsubishi Electric lanzará un GaN-HEMT MMIC en la banda Ka para estaciones terrestres de comunicación por satélite

Su elevada potencia de salida y baja distorsión ayudarán a reducir el tamaño de las estaciones terrestres de comunicación por satélite

TOKYO, 4 de octubre de 2017– [Mitsubishi Electric Corporation](http://www.MitsubishiElectric.com) (TOKYO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de un amplificador para circuitos monolíticos integrados de microondas (MMIC) de transistores de alta movilidad de electrones (HEMT) de nitruro de galio (GaN) de 8 W en la banda Ka (26–40 GHz) para su utilización en estaciones terrestres de comunicación por satélite. El nuevo MGFG5H3001, con una baja distorsión y una clasificación de potencia de salida de 8 W de primer nivel, ayudará a reducir las dimensiones de los transmisores de potencia gracias a su pequeño tamaño. Mitsubishi Electric comenzará a enviar muestras el 1 de noviembre.



GaN-HEMT MMIC en la banda Ka (MGFG5H3001)

Las redes por satélite, utilizadas para establecer comunicaciones de alta velocidad en caso de desastres naturales y en zonas en las que es difícil construir redes en tierra, se suelen implantar principalmente en las bandas C (4–8 GHz) y Ku (12–18 GHz), pero cada vez más se utilizan bandas de frecuencias más altas. Por otro lado, cada vez es mayor la demanda en el mercado de implantaciones en la banda Ka, también de elevada frecuencia. El nuevo GaN-HEMT MMIC en la banda Ka de Mitsubishi Electric ayudará a satisfacer la creciente demanda de implantaciones en frecuencias más altas y facilitará, además, el desarrollo de equipos de comunicación por satélite que puedan ofrecer mayor eficiencia y potencia de salida.

Características del producto

1) *Su potencia de salida de primer nivel contribuye a reducir el tamaño*

- La configuración optimizada del transistor proporciona una potencia de salida de 8 W de primer nivel
- Un único chip integra los circuitos de transistores amplificadores, circuitos emparejados y un linealizador que reduce la distorsión
- La disminución del número de piezas ayudará a reducir el tamaño de los transmisores utilizados en estaciones terrestres de comunicación por satélite

2) *Reducción de distorsión de primer nivel para una elevada integridad de señal y reducción de tamaño*

- La integración del linealizador permite la baja distorsión en transmisores de potencia
- La elevada integridad de la señal y la menor necesidad de contar con un linealizador externo permiten reducir el tamaño de los transmisores utilizados en estaciones terrestres de comunicación por satélite

3) *Facilitará la provisión de los nuevos equipos para estaciones de comunicación por satélite para satisfacer una mayor gama de demandas*

- Se espera que sea la opción preferida para los nuevos equipos en la banda Ka y para mejorar los equipos existentes en la banda Ku para instalaciones en gamas de frecuencia más diversas

Programa de ventas

Producto	Aplicación	Modelo	Descripción general			Envío
			Frecuencia	Potencia de salida en estado de saturación	Ganancia lineal	
GaN-HEMT MMIC en la banda Ka	Estaciones terrestres de comunicación por satélite	MGFG5H3001	27,5-31,0 GHz	39,0 dBm (8 W)	15,0 dB	1 de noviembre de 2017

Especificaciones principales

	Símbolo	MGFG5H3001
Tensión drenador-fuente	VDS	24 V
Frecuencia	27,5–31,0 GHz (banda Ka)	
Potencia de salida en estado de saturación	Pout (Typ.)	8 W
Ganancia lineal	Glp (Typ.)	15,0 dB

Gama de HEMT de GaN revisada (modelo nuevo en negrita)

Frecuencia	Modelo	Potencia de salida en estado de saturación [W]	Ganancia lineal [dB]
Banda Ka	MGFG5H3001	8	15,0
Banda Ku	MGFG5H1503	20	20,0
	MGFK47G3745A	50	8,0
	MGFK48G3745	70	10,0
	MGFK49G3745	80	7,5
	MGFK50G3745	100	10,0

Conciencia medioambiental

El producto cumple con la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS en inglés).

Nota: El desarrollo de este producto ha contado con el apoyo parcial de la organización para el desarrollo de energías nuevas y tecnologías industriales (NEDO) de Japón.

###

Acerca de Mitsubishi Electric Corporation

Con más de 90 años de experiencia en la provisión de productos fiables y de alta calidad, Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) es un líder mundial reconocido en la fabricación, comercialización y venta de equipos eléctricos y electrónicos utilizados en el procesamiento de la información y las comunicaciones, en el desarrollo espacial y las comunicaciones por satélite, en los aparatos electrónicos de consumo, en la tecnología industrial, en la energía, en el transporte y en los equipos de construcción. Aprovechando el espíritu de su declaración corporativa "Changes for the Better" y su declaración medioambiental "Eco Changes", Mitsubishi Electric se esfuerza por ser una empresa internacional comprometida con el medio ambiente líder y por enriquecer la sociedad con la tecnología. La empresa registró ventas de grupo consolidadas de 4238,6 mil millones de yenes (unos 37,8 mil millones de dólares estadounidenses*) en el ejercicio fiscal que terminó el 31 de marzo de 2017. Para obtener más información, visite:

<http://www.MitsubishiElectric.com>

*Tipo de cambio de 112 yenes por dólar estadounidense, tipo concedido por el Mercado de divisas de Tokio el 31 de marzo de 2017